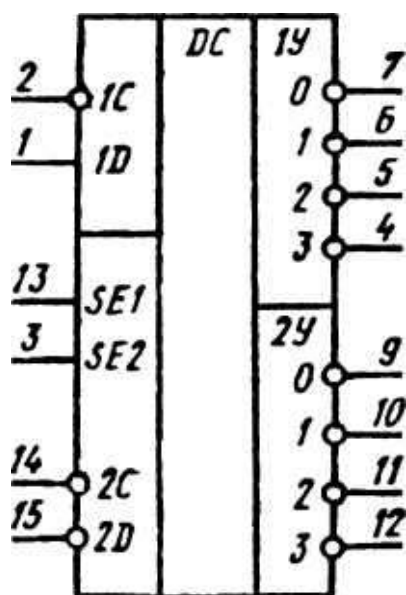


КР1533ИД4, КФ1533ИД4, ЭКФ1533ИД4

Микросхемы, представляют собой сдвоенный дешифратор-демультиплексор 2-4. Могут использоваться в качестве сдвоенного дешифратора 2 на 4; сдвоенного демультиплексора 1 на 4; дешифратора 3 на 8; демультиплексора 1 на 8. Содержат 211 интегральных элементов. Корпус типа 238.16-1, масса не более 1,2 г, 4307.16-А

Назначение выводов: 1 - вход информационный $1D$; 2 - вход стробирования $\overline{1C}$; 3 - вход выбора данных $SE2$; 4 - выход $\overline{1Y}.3$; 5 - выход $\overline{1Y}.2$; 6 - выход $\overline{1Y}.1$; 7 - выход $\overline{1Y}.0$; 8 - общий; 9 - выход $\overline{2Y}.0$; 10 - выход $\overline{2Y}.1$; 11 - выход $\overline{2Y}.2$; 12 - выход $\overline{2Y}.3$; 13 - вход выбора данных $SE1$; 14 - вход стробирования $\overline{2C}$; 15 - вход информационный $2D$; 16 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ИД4, КФ1533ИД4, ЭКФ1533ИД4

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня при $U_n = 4,5$ В	≤ 0,4 В
Выходное напряжение высокого уровня при $U_n = 4,5$ В.....	≥ 2,5 В
Входной ток низкого уровня	≤ -0,2 мА
Входной ток высокого уровня (для одиночного входа)	≤ 20 мкА
Ток потребления при $U_n = 5,5$ В	≤ 7 мА
Время задержки распространения при включении (выключении):	
- от любого входа $SE1$, $SE2$, $2D$, $2C$, $1C$ к выходу Y	≤ 28 нс
- от любого входа $SE1$ или $SE2$ к выходу Y	≤ 32 нс
- от входа $1D$ к выходу Y	≤ 26 нс

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Максимальный выходной ток низкого уровня	4 мА
Максимальный выходной ток высокого уровня	-4 мА
Напряжение питания	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход	5,5 В
Температура окружающей среды	-10...+70 °С

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при

температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения $5 \text{ В} \pm 10\%$, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.